

0,1-0,2 мкм, поверхневий опір – 1 Ом/см². Концентрація дірок в Cu_{1.8}S $p=5 \cdot 10^{21}$ см⁻³, концентрація електронів в CdSe $n=10^{15}$ см⁻³.

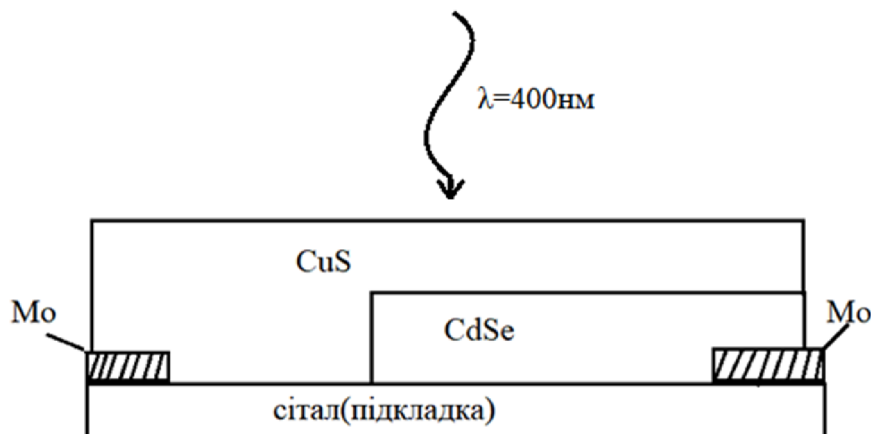


Рисунок 1.1 – Схема фотоперетворювача CuS_{1.8}–CdSe та його освітлення.

Освітлення зразка проводилося зі боку Cu_{1.8}S. При цьому використовувалось монохроматичне світло з довжиною хвилі 400 нм. Джерелом слугував світловипромінюючий діод РМ2В-1LLE. Для забезпечення сталої величини світлового потоку підтримувалося постійне значення сили струму через діод ($200 \pm 0,1$ мА) та його температура ($30 \pm 0,2$ °С, за допомогою термостату W1209).

На рис.1.2 наведено схему ультразвукового навантаження фотоелектричного перетворювача.

